

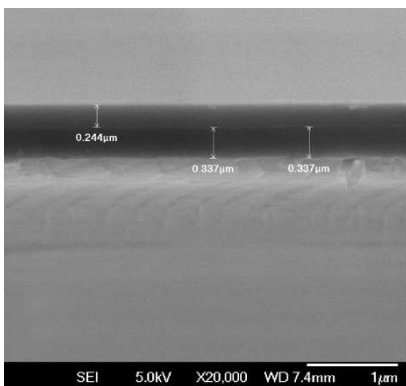
アプリケーション

弊社のカスタマイズされた薄膜 SOI のソリューションは以下の分野につかわれております。:

- RF フィルター
- 光エレクトロニクス
- 画像検出
- ワイヤレスコネクション
- フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス
- RF MEMS

最終市場:

- テレコミュニケーション
- 一般消費者向け
- 電源
- 医療

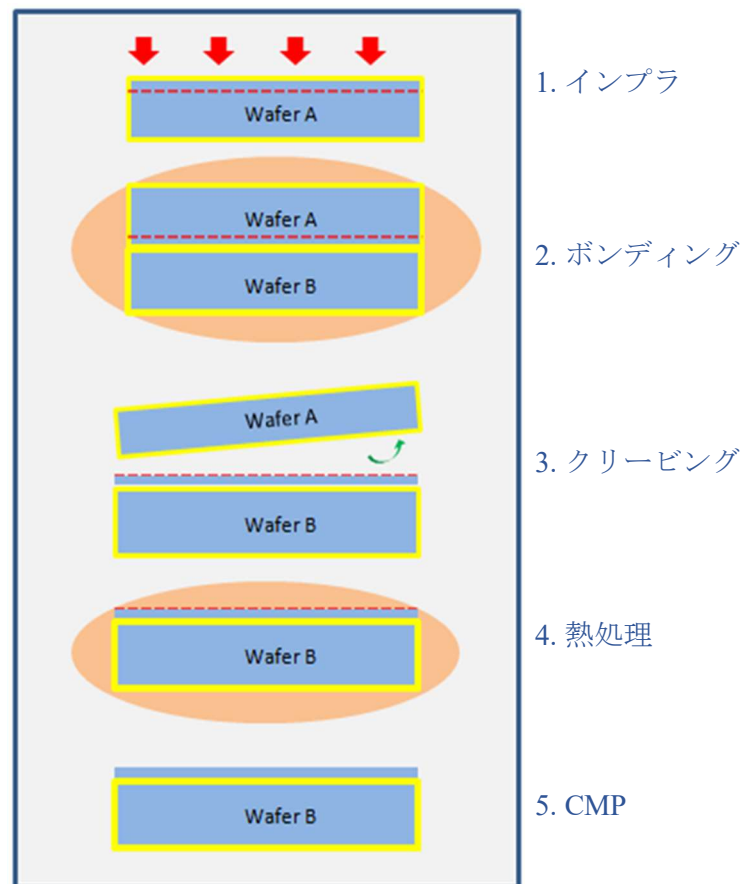


SEM image of IceMOS 245nm Thin-SOI Wafer

アイスモス・テクノロジーは薄膜の SOI ウエハーを<1µm 以下のデバイスレイヤーにて供給いたします。20 年以上の SOI 製造の経験により、アイスモスは RF アプリケーションに使われる厚膜 SOI と同様の高い品質の製品をご提供できます。

シリコンウエハーや熱酸化膜など広い範囲で、アイスモスの薄膜 SOI ウエハーは光工学表面弾性波フィルターなどの分野などをカバーできます。

6 シグマの統計学的管理手法に基づくプロセス管理で常に継続的改善を進めながら、アイスモスは世界クラスの製品品質を提供いたします。十分に競争できるコストと柔軟な対応で、アイスモスは御社の理想的なパートナーであり続けます。



Thin-SOI Specification

パラメーター	仕様 範囲
ウェハー直径	150 - 200 mm
ハンドル層仕様	
ドーパント タイプ	N または P
ドーピング	N type: Phos, Sb & As P type: Boron
抵抗率	$\leq 0.001 - \geq 10000 \Omega\text{-cm}$
シリコン成長方法	CZ, MCZ または FZ
埋め込み酸化膜仕様	
熱酸化膜、埋め込み酸化膜厚	0.1 μm - 2 μm 成長、デバイス、もしくはハンドルと両方
埋め込み酸化膜 均一性	$\pm 5\%$
デバイス層の仕様	
デバイス層 膜厚	0.1 μm - 1 μm
デバイス 厚さ 公差範囲	$\pm 20\text{nm}$
ドーパントタイプ	N または P
ドーピング	N type: Phos, Sb & As P type: Boron
抵抗率	$\leq 0.001 - \geq 10000 \Omega\text{-cm}$
シリコン成長方法	CZ, MCZ or FZ
結晶方位	$\langle 100 \rangle$, $\langle 111 \rangle$ or $\langle 110 \rangle$

上記は標準の仕様ですが、特定の仕様のソリューションについて、喜んでお客様のご要望を検討させていただきます。
他のスペックなどお問合せなどがありましたら、セールsteamへコンタクトして下さい: sales@icemostech.com